









	<h2 style="color: red;">IPD090N03LGBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD090N03LGBTMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 40A TO252
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD090N03LGBTMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD090N03LGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

IPD090N03LGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD090N03LGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD090N03LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD090N03LGBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD090N03LAG</b> INFINEO IPD090N03LAG INFINEO</p>	 <p><b>IPD096N08N3G</b> INFINEO IPD096N08N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPD096N08N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 73A TO252-3</p>	 <p><b>IPD090N03LG</b> INFINEO IPD090N03LG INFINEO</p>
 <p><b>IPD090N03L G</b> INFINEO IPD090N03L G INFINEO</p>	 <p><b>IPD090N03LA</b> VB IPD090N03LA VB</p>	 <p><b>IPD09N03</b> Infineon IPD09N03 Infineon</p>	 <p><b>IPD090N03LGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 40A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD090N03LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD090N03LGBTMA1 Datenblatt	IPD090N03LGBTMA1-Datenblätter	IPD090N03LGBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD090N03LGBTMA1
IPD090N03LGBTMA1 Electronic	IPD090N03LGBTMA1-Komponenten	IPD090N03LGBTMA1-Verteiler	IPD090N03LGBTMA1-Bild	IPD090N03LGBTMA1-Teil
IPD090N03LGBTMA1 Preis	IPD090N03LGBTMA1 Hersteller	IPD090N03LGBTMA1 Bild	IPD090N03LGBTMA1 Aktie	IPD090N03LGBTMA1 Inventar
IPD090N03LGBTMA1 Neu	IPD090N03LGBTMA1 Original	IPD090N03LGBTMA1 garantiert	IPD090N03LGBTMA1 RFQ	IPD090N03LGBTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited